

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出願人代理人

菅原 正倫

様

あて名

〒 460-0008

愛知県名古屋市中区栄二丁目9番30号  
栄山ビル 菅原国際特許事務所

PCT

国際調査報告及び国際調査機関の見解書  
又は国際調査報告を作成しない旨の決定  
の送付の通知書  
(法施行規則第41条)  
[PCT規則44.1]

発送日

(日.月.年)

18.5.2004

出願人又は代理人  
の書類記号

PCT0301252S

今後の手続きについては、下記1及び4を参照。

国際出願番号

PCT/JP2004/004405

国際出願日  
(日.月.年)

29.03.2004

出願人 (氏名又は名称)

信越半導体株式会社

1. ☒ 国際調査報告及び国際調査機関の見解書が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。  
PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出  
出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる (PCT規則46参照)。  
いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。  
どこへ 直接次の場所へ The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland  
Facsimile No.: (41-22)740.14.35  
詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。
2. ☐ 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項 (PCT17条(2)(a)) の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定及び国際調査機関の見解書をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
3. ☐ 法施行規則第44条 (PCT規則40.2) に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人に下記の点を通知する。  
☐ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。  
☐ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。
4. 今後の手続： 出願人は次の点に注意すること。  
優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むときは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。  
いくつかの指定官庁については、出願人が国内段階の開始を優先日から30月まで (官庁によってはさらに遅くまで) 延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。そうでなければ、出願人はそれらの指定官庁に対して優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定の手続を取らなければならない。  
その他の指定官庁については、19月以内に国際予備審査の請求書が提出されない場合にも、30月の (あるいはさらに遅い) 期限が適用される。  
様式PCT/IB/301の付属書類を参照。個々の指定官庁で適用される期限の詳細については、PCT出願人の手引、第II巻、国内段階およびWIPOインターネットサイトを参照。

名称及びあて名

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

2K

3106

電話番号 03-3581-1101 内線 3253

## 注 意

1. 国際調査報告の発送日から起算する条約第19条(1)及び規則46.1に従う国際事務局への補正期間に注意してください。

2. 条約22条(2)に規定する期間に注意してください。

3. 文献の写しの請求について

国際調査報告に記載した文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階)  
独立行政法人工業所有権総合情報館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

(1) 特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)

○必要部数

(2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際調査報告の写しを添付してください(返却します)。

[申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注意 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

## 様式PCT/ISA/220の備考

この備考は、PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する基本的な指示を与えるためのものである。この備考は特許協力条約並びにこの条約に基づく規則及び実施細則の規定に基づいている。この備考とそれらの規定とが相違する場合には、後者が適用される。詳細な情報については、WIPOの出版物であるPCT出願人の手引も参照すること。

### PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する指示

出願人は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受領した後、国際出願の請求の範囲を補正する機会が一回ある。しかし、国際出願のすべての部分（請求の範囲、明細書及び図面）が、国際予備審査の手續においても補正できるもので、例えば出願人が仮保護のために補正書を公開することを希望する場合又は国際公開前に請求の範囲を補正する別の理由がある場合を除き、通常PCT 19条の規定に基づく補正書を提出する必要はないことを強調しておく。さらに、仮保護は一部の国のみで与えられるだけであることも強調しておく（PCT出願人の手引、附録B 1及びB 2参照）。

#### 補正の対象となるもの

PCT 19条の規定により請求の範囲のみ補正することができる。

国際段階においてPCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手續において請求の範囲を（更に）補正することができる。

明細書及び図面は、PCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手續においてのみ補正することができる。

国内段階に移行する際、PCT 28条（又はPCT 41条）の規定により、国際出願のすべての部分を補正することができる。

#### いつ

国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月の内どちらか遅く満了するほうの期間内。しかし、その期間の満了後であっても国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局が補正を受領した場合には、その補正書は、期間内に受理されたものとみなすことを強調しておく（PCT規則46.1）。

#### 補正書を提出すべきところ

補正書は、国際事務局のみに提出でき、受理官庁又は国際調査機関には提出してはいけない（PCT規則46.2）。国際予備審査の請求書を提出した／する場合には、以下を参照すること。

#### どのように

1以上の請求の範囲の削除、1以上の新たな請求の範囲の追加、又は1以上の請求の範囲の記載の補正による。

差替え用紙は、補正の結果、出願当初の用紙と相違する請求の範囲の各用紙毎に提出する。

差替え用紙に記載されているすべての請求の範囲には、アラビア数字を付さなければならない。請求の範囲を削除する場合、その他の請求の範囲の番号を付け直す必要はない。請求の範囲の番号を付け直す場合には、連続番号で付け直すなければならない（PCT実施細則第205号(b)）。

補正は国際公開の言語で行う。

#### 補正書にどのような書類を添付しなければならないか

##### 書簡（PCT実施細則第205号(b)）

補正書には書簡を添付しなければならない。

書簡は国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開されることはない。これを「PCT 19条(1)に規定する説明書」と混同してはならない（「PCT 19条(1)に規定する説明書」については、以下を参照）。

書簡は、英語又は仏語を選択しなければならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、書簡は英語で、仏語の場合、書簡は仏語で記載しなければならない。

書簡には、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違について表示しなければならない。特に、国際出願に記載した各請求の範囲との関連で次の表示（2以上の請求の範囲についての同一の表示する場合は、まとめることができる。）をしなければならない。

- (i) この請求の範囲は変更しない。
- (ii) この請求の範囲は削除する。
- (iii) この請求の範囲は追加である。
- (iv) この請求の範囲は出願時の1以上の請求の範囲と差し替える。
- (v) この請求の範囲は出願時の請求の範囲の分割の結果である。

次に、添付する書簡中での、補正についての説明の例を示す。

1. [請求の範囲の一部の補正によって請求の範囲の項数が48から51になった場合] :  
“請求の範囲1-29、31、32、34、35、37-48項は、同じ番号のもとに補正された請求の範囲と置き換えられた。請求の範囲30、33及び36項は変更なし。新たに請求の範囲49-51項が追加された。”
2. [請求の範囲の全部の補正によって請求の範囲の項数が15から11になった場合] :  
“請求の範囲1-15項は、補正された請求の範囲1-11項に置き換えられた。”
3. [原請求の範囲の項数が14で、補正が一部の請求の範囲の削除と新たな請求の範囲の追加を含む場合] :  
“請求の範囲1-6及び14項は変更なし。請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。” 又は  
“請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。その他の全ての請求の範囲は変更なし。”
4. [各種の補正がある場合] :  
“請求の範囲1-10項は変更なし。請求の範囲11-13、18及び19項は削除。請求の範囲14、15及び16項は補正された請求の範囲14項に置き換えられた。請求の範囲17項は補正された請求の範囲15、16及び17項に分割された。新たに請求の範囲20及び21項が追加された。”

“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”(PCT規則46.4)

補正書には、補正並びにその補正が明細書及び図面に与える影響についての説明書を提出することができる(明細書及び図面はPCT19条(1)の規定に基づいては補正できない)。

説明書は、国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開される。

説明書は、国際公開の言語で作成しなければならない。

説明書は、簡潔でなければならず、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を越えてはならない。

説明書は、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違を示す書簡と混同してはならない。説明書を、その書簡に代えることはできない。説明書は別紙で提出しなければならず、見出しを付すものとし、その見出しは“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”の語句を用いることが望ましい。

説明書には、国際調査報告又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して、これらを誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

#### 国際予備審査の請求書が提出されている場合

PCT19条の規定に基づく補正書及び添付する説明書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、補正書(及び説明書)を国際事務局に提出すると同時にその写し及び必要な場合、その翻訳文を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(PCT規則55.3(a)、62.2の第1文を参照)。詳細は国際予備審査請求書(PCT/IPEA/401)の注意書参照。

国際予備審査の請求がされた場合は、見解書を作成した国際調査機関が国際予備審査機関としては行動しないという特定の場合を除いて、国際調査機関の見解書は国際予備審査機関の見解書とみなされる。この場合、様式PCT/ISA/220の送付日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる(PCT規則43の2.1(c))。

#### 国内段階に移行するための国際出願の翻訳に関して

国内段階に移行する際、PCT19条の規定に基づいて補正された請求の範囲の翻訳を出願時の請求の範囲の翻訳の代わりに又は追加して、指定官庁/選択官庁に提出しなければならないこともあるので、出願人は注意されたい。

指定官庁/選択官庁の詳細な要求については、PCT出願人の手引きの第II巻を参照。



P C T

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)  
[P C T 18条、P C T 規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号	P C T 0 3 0 1 2 5 2 S	今後の手続きについては、様式P C T / I S A / 2 2 0 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 2 0 0 4 / 0 0 4 4 0 5	国際出願日 (日.月.年) 2 9 . 0 3 . 2 0 0 4	優先日 (日.月.年) 0 9 . 0 5 . 2 0 0 3	
出願人 (氏名又は名称) 信越半導体株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (P C T 18条) の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる (第 I 欄参照)。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 II 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 III 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条 (P C T 規則38.2(b)) の規定により  
国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ  
の国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 図面に関して

a. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ 出願人は図を示さなかったため、国際調査機関が選択した。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表しているため、国際調査機関が選択した。

b. ☐ 要約とともに公表される図はない。

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L31/04, H01L21/318

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L31/04, H01L21/318

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P 2-500397 A (モバイル・ソーラー・エネルギー・コーポレーション) 1990.02.08, 全文, 全図 & WO 89/00341 A & DE 3790981 A & EP 325606 A1 & GB 2215129 A & KR 9601468 B	1, 3, 4, 6, 7 2, 5, 8-23

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21.04.2004

国際調査報告の発送日

18.5.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

濱田 聖司

2K

3106

電話番号 03-3581-1101 内線 3253

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	J P 9-97916 A (シャープ株式会社) 1997.04.08, 全文, 全図 (ファミリーなし)	2, 9, 13, 17, 18, 22 1, 3-8, 10-12, 14-16, 19-21, 23
Y	J P 10-209151 A (日本電気株式会社) 1998.08.07, 全文, 全図 & US 6225241 B1	5, 8-23
Y	J P 10-83988 A (松村英樹) 1998.03.31, 全文, 全図 & US 6069094 A1 & US 2002/0086557 A1 & US 6349669 B1	10, 11, 19, 20
Y	J P 2000-216163 A (富士通株式会社) 2000.08.04, 全文, 全図 (ファミリーなし)	12, 13, 21-23
A	J P 6-291114 A (株式会社リコー) 1994.10.18, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-8, 14-16
A	J P 9-205209 A (東芝電子エンジニアリング株式会社) 1997.08.05, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-8, 14-16
A	A Kudo et al, "Study on improvement on uniformity of Cat-CVD SiNx thin films", Technical Report of IEICE, ED99-10 (1999-04)	5, 8-23

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人

菅原 正倫

様

あて名

〒 460-0008

愛知県名古屋市中区栄二丁目9番30号 栄山ビル  
菅原国際特許事務所

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]

発送日  
(日.月.年)

18. 5. 2004

出願人又は代理人  
の書類記号

PCT0301252S

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2004/004405

国際出願日

(日.月.年) 29. 03. 2004

優先日

(日.月.年) 09. 05. 2003

国際特許分類 (IPC)

Int. Cl<sup>7</sup> H01L31/04, H01L21/318

出願人 (氏名又は名称)

信越半導体株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

☒ 第I欄 見解の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☐ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☒ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

21. 04. 2004

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
濱田 聖司

2K

3106

電話番号 03-3581-1101 内線 3253



## 第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲

2, 5, 8-23

有

請求の範囲

1, 3, 4, 6, 7

無

進歩性 (IS)

請求の範囲

有

請求の範囲

1-23

無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲

1-23

有

請求の範囲

無

## 2. 文献及び説明

文献1: JP 2-500397 A

(モバイル・ソーラー・エネルギー・コーポレーション)

1990.02.08, 全文, 全図

&amp; WO 89/00341 A &amp; DE 3790981 A

&amp; EP 325606 A1 &amp; GB 2215129 A

&amp; KR 9601468 B

文献2: JP 9-97916 A (シャープ株式会社)

1997.04.08, 全文, 全図

(ファミリーなし)

文献3: JP 10-209151 A (日本電気株式会社)

1998.08.07, 全文, 全図

&amp; US 6225241 B1

文献4: JP 10-83988 A (松村英樹)

1998.03.31, 全文, 全図

&amp; US 6069094 A

&amp; US 6349669 B1

&amp; US 2002/0086557 A1

文献5: JP 2000-216163 A (富士通株式会社)

2000.08.04, 全文, 全図

(ファミリーなし)

文献6: JP 6-291114 A (株式会社リコー)

1994.10.18, 全文, 全図

(ファミリーなし)

文献7: JP 9-205209 A

(東芝電子エンジニアリング株式会社)

1997.08.05, 全文, 全図 (ファミリーなし)

文献8: A Kudo et al,

"Study on improvement on uniformity of Cat-CVD SiNx thin films",

Technical Report of IEICE, ED99-10 (1999-04)

## 第Ⅶ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲 3 には「前記低水素含有無機絶縁膜」との記載がある。ここで、請求の範囲 3 は請求の範囲 1 又は 2 を引用するものであり、例えば請求の範囲 2 を引用する場合には、上記の「前記低水素含有無機絶縁膜」が、受光面側絶縁膜を指すのか裏面側絶縁膜を指すのか、それとも双方であるのか、不明である。

また、請求の範囲 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23 にも「前記低水素含有無機絶縁膜」、「前記無機絶縁膜」等の記載があり、上記と同様に受光面側の絶縁膜を指すのか裏面側絶縁膜を指すのか、それとも双方であるのか、不明となっている。

従って、請求の範囲 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23 は、不明確である。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V.2 欄の続き

請求の範囲 1 - 4, 6, 7

文献 1 には、化学式  $\text{Si}_x\text{H}_y\text{N}_z$  ( $x$  及び  $z$  は約 1.0 乃至 1.3、 $y$  は約 0.05 乃至 0.30) で表されるポリシラザン被膜を、太陽電池の前面上に形成すること、またこの被膜の屈折率が約 2.15 であることが記載されている。

従って、請求の範囲 1, 3, 4, 6, 7 に係る発明は、新規性を有しない。

また、シリコン窒化膜を半導体装置の保護膜等として用いる際に、膜中含有水素量を少なくすることは、従来周知の技術でもある。例えば、文献 6, 7 を参照。

また、文献 2 には、太陽電池において表裏両面に窒化シリコン膜を設けること、また裏面においては窒化シリコン膜に設けられた開口を介して裏面電極が接続されることが記載されている。なお、この技術は従来周知のものでもある。

文献 1 においては裏面には窒化シリコン膜を設けていないが、表裏両面に窒化シリコン膜を設けるものとし、請求の範囲 2 に係る発明とすることは、当業者にとって容易である。従って、請求の範囲 2 に係る発明は、進歩性を有しない。

請求の範囲 5, 8 - 23

文献 1 及び 2 については上記の通りである。

文献 3 には、半導体装置の表面を覆う  $\text{SiN}$  膜を触媒 CVD 法によって形成すること、また、触媒 CVD 法を用いればプラズマ CVD 法に比べてプラズマダメージが減少し、膜中水素量も減少することが記載されている。

文献 1, 2 に記載された発明ではいずれもプラズマ CVD 法を用いているが、プラズマダメージを減少させる等のために、プラズマ CVD 法にかえて文献 3 の触媒 CVD 法を用いることは、当業者にとって容易である。

なお、触媒 CVD 法で窒化シリコン膜を形成する際に、屈折率や原料ガス混合比を適宜調整可能であることは、文献 8 に記載されている。

また、シリコン窒化膜を触媒 CVD 法で形成する前に、表面処理用ガスを導入して触媒体と接触させることにより表面処理を行うこと（請求の範囲 10, 11, 19, 20）については、文献 4 に記載されている。触媒 CVD 法で  $\text{SiN}$  膜を形成した後に、触媒体にガスを吹き付けることにより後処理を行うこと（請求の範囲 12, 13, 21 - 23）については、文献 5 に記載されている。上記のように触媒 CVD 法を用いる際に、文献 4, 5 に記載されたような表面処理及び後処理をも採用することは、当業者が容易になし得るものである。

以上より、請求の範囲 5 及び 8 - 23 は、進歩性を有しない。